

Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ 세라믹스의 유전 및 압전성에 미치는 MnO₂의 영향

김종선* · 윤기현 · 최병현** · 박종목** · 이종민**

연세대학교 요업공학과

*삼성코닝 연구소

**도자기 시험소

(1989년 12월 19일 접수)

Effects of MnO₂ on the Dielectric and Piezoelectric Properties of Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ Ceramics

J.S. Kim*, K.H. Yoon, B.H. Choi**, J.O. Park** and J.M. Lee**

Dept. of Ceramic Eng., Yonsei University

*R & D Center, Samsung Corning Ltd.

**Institute of Ceramic Research

(Received December 19, 1989)

요약

Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ 세라믹에 MnO₂를 0.0~5.0wt% 까지 첨가시 미세구조와 유전성 및 압전성에 미치는 영향을 연구하였다.

Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃에 대한 MnO₂의 고용한계는 약 0.5wt%이고, MnO₂는 Mn³⁺의 원자가 상태로 PZT 고용체내의 (Zr, Ti) 격자위치로 치환되었다.

Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃에 MnO₂를 0.5wt% 까지 첨가시 밀도는 증가하였으나 결정립 크기와 tetragonality는 감소하였다. 유전상수는 약간 감소하였으나 전기기계 결합계수(K_p)와 기계적 품질계수(Q_m)는 MnO₂의 첨가로 인하여 증가하였다. 그러나 0.75wt% 이상의 과량의 MnO₂를 첨가하였을 때 저항은 급격히 감소하였다.

유전상수와 tanδ는 이차상의 존재와 Mn 분포의 불균일로 인하여 증가하였다.

ABSTRACT

Effects of MnO₂ addition ranged from 0.0wt% to 5.0wt% on the microstructure and dielectric and piezoelectric properties of the Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ Ceramics have been investigated.

The solubility limit of MnO₂ in Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ is about 0.5wt%, and MnO₂ as a valence state of Mn³⁺ is substituted for (Zr, Ti) lattice site in PZT solid-solution.

The addition of MnO₂ up to 0.5wt% in Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ brings increase of density, but decrease of grain size and tetragonality. Dielectric constant slightly decreases, but both coupling factor(K_p) and mechanical quality factor(Q_m) increase with the addition of MnO₂.

However, excess amount of MnO₂ addition more than 0.75wt% results in rapid decrease of resistance.

1. 서 론

압전 세라믹스는 진동, 변형, 압력 등의 기계적 에너지를 전기적 에너지로 혹은 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 소자로서의 기능을 가지며 조성의 개선 및 제조 기술의 진보가 계속되어 세라믹스의 압전 특성은 향상되어 왔다. 또한, 압전 특성의 개선에 따라 응용 분야가 넓어지게 되어 발진자, 필터, 공진기와 같이 전기적 응답을 응용한 압전 진동자와 전기 음향변성기, 점화장치, 센서 등 에너지 변화 목적에 따라 매우 폭넓게 응용되고 있다.

PZT($\text{Pb}(\text{Zr}_{x}\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$)계의 전기적 물리적 성질은 출발 물질의 특성 및 제조 조건에 많은 영향을 받으며 특히 조성 변화 및 소량 첨가물에 의하여 물성이 크게 변하므로 donor나 acceptor 첨가 영향 및 이들의 복합적인 첨가 효과, 복합 perovskite 와의 삼성분계 등에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다^{1,2)}.

첨가물들은 원자가 상태와 PZT 고용체 내로의 치환 위치 및 특성에 대한 효과에 따라 크게 hardner, softner, 그리고 stabilizer로서 구분되는데 특히 MnO_2 는 Ouchi 등³⁾과 Zhong⁴⁾이 보고한 바와 같이 stabilizer로서 작용하며 압전 성질 및 온도 안정성을 향상시켜 주는 역할을 한다고 보고되고 있다. 또한 열처리 분위기에 따라 Hagemann⁵⁾의 보고와 같이 침가 효과도 변화하게 될 것으로 본다. 그러나 순수한 PZT 자체에 대한 MnO_2 첨가 영향에 대해서는 체계적인 연구가 미비한 실정이다.

따라서, 본 연구에서는 정방정계(tetragonal)와 삼방정계(rhombohedral)의 공존 영역 조성인 $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$ 를 기본 조성으로 하여 MnO_2 를 첨가하였을 때 미세구조와 유전성 및 압전성에 대한 영향을 고찰해 보고자 한다.

2. 실 험

PbO , ZrO_2 , TiO_2 , MnO_2 를 출발물질로 모두 고순도의 특급 시약을 사용하였으며 $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$ 를 기본 조성으로 하여 MnO_2 를 0.0wt%에서 5.0wt%까지 첨가하였으며 일반적인 요업체 제조 공정에 의거하여 시편을 제조하였다.

원료를 조성에 따라 batch 20g으로 각각 칭량한 후 12

시간동안 습식 혼합하였으며 ball mill 후 hot magenetic stirrer를 사용하여 교반하면서 건조하였다. 건조 후 alumina 도가니를 사용하여 850°C에서 6시간 동안 하소하여 PZT를 합성하였다. 합성 후 분쇄하여 전조시킨 다음 지름 14mm의 원형 steel 몰드에서 1500kg/cm²의 압력을 가하여 원판형으로 성형하였다. 이때 binder의 영향을 배제하기 위하여 성형사 binder는 첨가하지 않았다.

소결은 1200°C에서 4시간 동안 300°C/hr의 승온 속도로 열처리하여 수행하였으며 $\text{PbZrO}_3+5\text{wt\% ZrO}_2$ 를 분위기 분말로 사용하고 alumina 도가니를 배열하여 밀봉시키서 PbO 분위기를 유지시켰다

소결 후 신수축율과 밀도를 측정하였다. 한편 MnO_2 의 격자 치환 효과를 보기 위하여 소결전(건조무게)과 소결후의 무게 변화를 전자 balance(Satorious 2434, Germany)를 이용하여 정밀하게 측정하였다. 또한 하소후의 PZT 생성 및 미반응 물질의 존재 여부 확인과 소결후 존재상과 격자 상수 변화를 보기 위하여 X-선 회절 분석(Rigaku Co., Japan)을 수행하였으며 이때 격자 상수는 least-square method를 사용하여 계산하였다.

소성 시편은 SiC 연마지(#800, 1000, 1200)를 사용하여 두께 0.5mm로 얻어한 후 초음파 세척기로 잘 세척하여 표면의 오염을 잘 제거한 후 silver paste를 사용하여 700°C, 10분간 열처리하여 전극을 부착하였다.

전극 부착후 LCR meter(Ando Electric Co., AG4303)를 이용하여 유전상수와 $\tan \delta$ 를 1KHz에서 측정하였다. 또한 유전 상수의 주파수 의존성을 측정하기 위하여 LCZ meter(4192A, Hewett Packard Co., USA)로서 5Hz에서 13MHz 사이에서 Capacitance를 측정하였다. 한편 megohm meter(IM6, Denmark)를 사용하여 상온 저항을 측정하였다.

분극 처리는 100°C의 silicon oil bath에서 10-30KV/cm의 전계를 20분 동안 가하여 수행하였으며 K_p 및 Q_m 을 IRE standard에 근거하여 공진-반공진 방법에 의하여 측정하였다.

또한 소결 시편의 결정립 크기 및 이차상의 생성 여부 등을 관찰하기 위하여 파단면과 연마면에 대하여 금속 현미경(Nikon, type 104, Japan)과 EDAX가 부착된 SEM(Jeol JXA-840A)을 이용하여 미세구조를 조사하였다.

3. 결과 및 고찰

MnO_2 는 산소 분입 및 PbO 증기압에 따라 여러 가지의 원자가 상태로서 존재할 수 있으나 MnO_2 의 열처리 온도에 따른 열분해 반응에 의하면 PZT 생성 반응이 이루어지는 하소 온도 범위에서는 3^+ 상태로서의 치환을, 그리고 소결 온도에서는 2^+ 및 3^+ 로서의 치환을 예상할 수 있으며⁵⁻⁷⁾ PZT 격자중 B site로의 치환이 가능함을 이온 반응 (Pb^{2+} , 1.21, Zr^{4+} ; 0.80, Ti^{4+} ; 0.68, O^{2-} ; 1.40, Mn^{4+} ; 0.54, Mn^{3+} , 0.66, Mn^{2+} , 0.80)에서 일 수 있다⁶⁾.

Fig. 1은 Mn⁴⁺의 형태로 B site에 치환되고 또한 B site에서의 vacancy 생성을 무시하였을 때 Atkin 등의 보고⁵와 같이 이론적인 무게 증가량과 소결 전후의 무게변화 측정 장치를 비교한 것이며 약 0.5~0.75wt% MnO₂첨가시까지 이론값과 실험치가 잘 일치함을 볼 수가 있다. 이때 결합반응식은 식(1)과 같이 나타낼 수 있다.

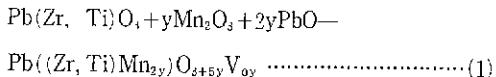


Fig. 2는 MnO_2 첨가량에 따른 격자 상수 및 tetragonal-ity 변화를 나타낸 것으로서 첨가량 증가에 따라 0.5wt% 까지 격자 상수 c 및 단위 격자 부피는 급속히 감소하되 tetragonality는 거의 0.75wt% MnO_2 까지 계수적으로 감소함을 알 수가 있다. 이는 Mn의 격자 site에의 치환 효과에 기인된 것으로 MnO_2 는 대부분 Mn^{3+} 의 형태로 B site에 치환된다고 생각 할 수 있다.

Fig. 3은 첨가량에 따른 밀도, 수축율 및 기공율 변화를

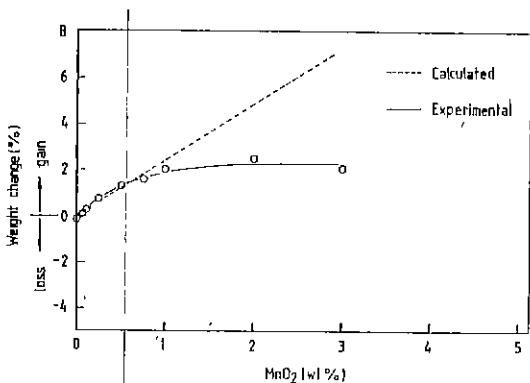


Fig.1. Weight change after sintering for the MnO₂ doped Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O₃ Ceramics

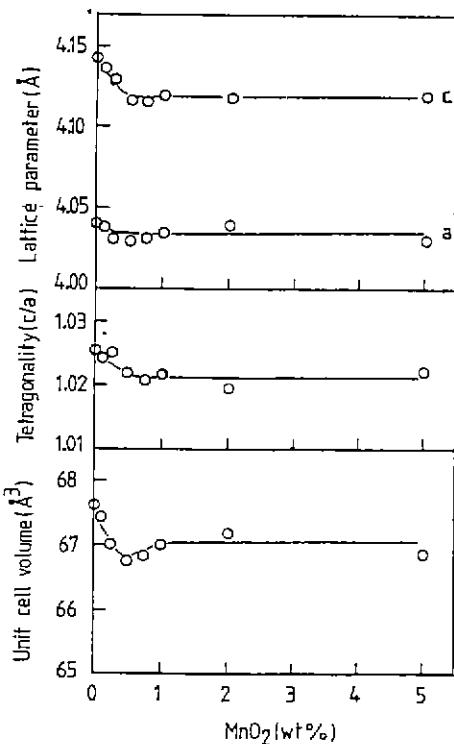


Fig.2. Effect of MnO_2 on the lattice parameter, tetragonality, and unit cell volume of $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.62}\text{Ti}_{0.18})\text{O}_3$.

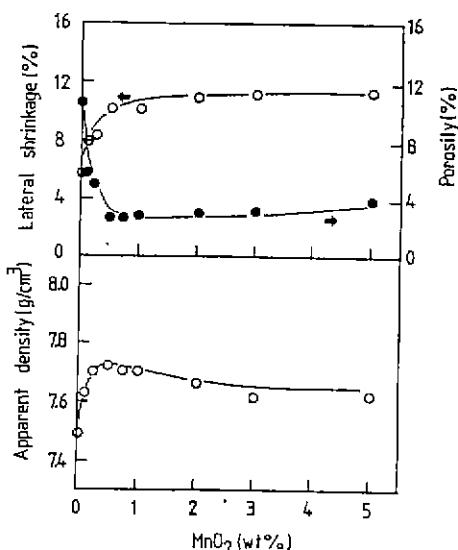
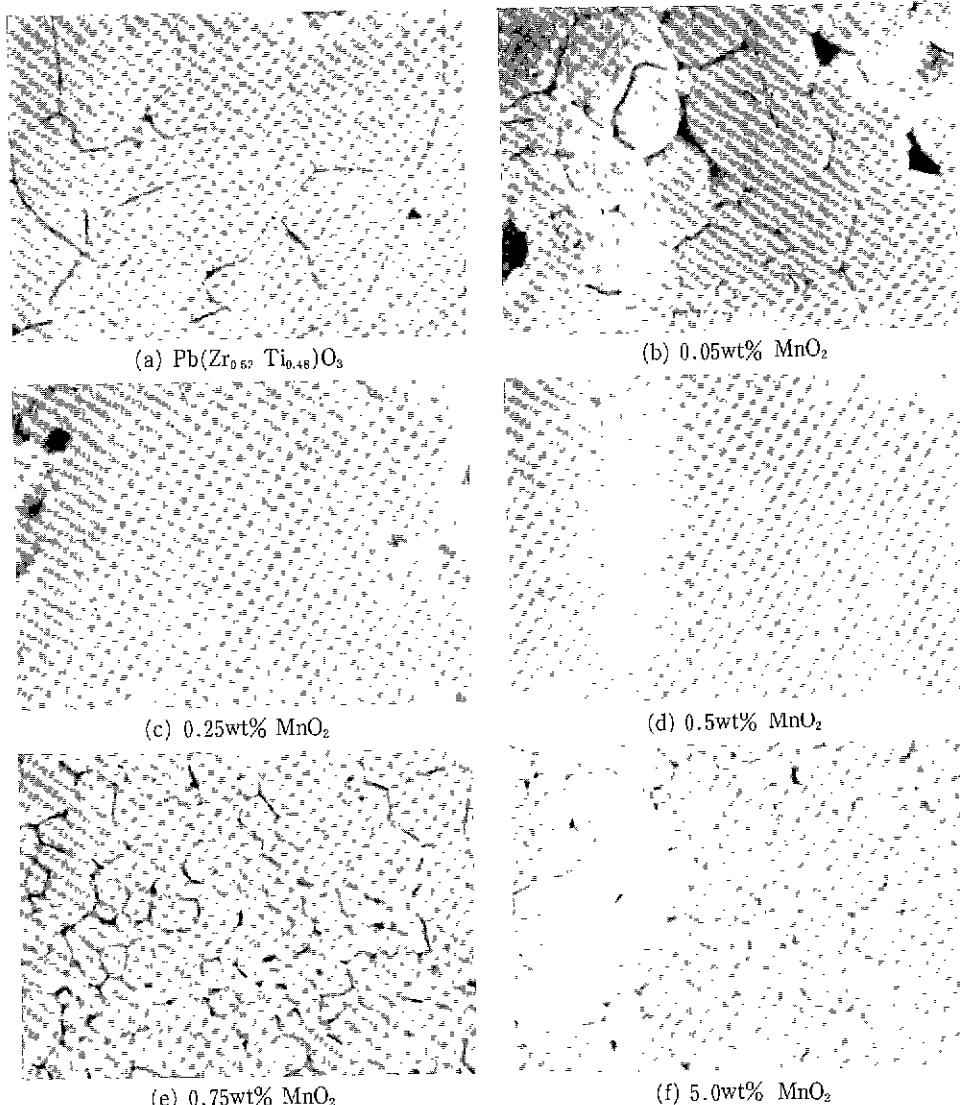


Fig 3. Variation of apparent density, lateral shrinkage, and porosity with MnO_2 addition

Fig. 4. Scanning electron microscopy of the etched $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52} \text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$ with MnO_2 addition.

나타낸 것이며 Fig.4는 etching 후의 미세 구조 변화를 보여주고 있다. 첨가량 증가에 따라 0.5wt% MnO_2 까지 밀도, 수축율은 증가하고 기공율은 감소하고 있으며 그 이상의 첨가에 대해서는 수축율과 기공율의 원만한 증가현상에 비하여 밀도는 원만한 감소현상을 보여주고 있다. 또한 Fig.4에서 볼 수 있듯이 결정립 크기는 0.25wt% MnO_2 까지 급속하게 감소하여 0.5wt% 까지 감소하여 이 후는 약간의 증가 현상을 나타낼을 볼 수가 있다. 급속한 수축율 증가 및 기공율 감소 현상과 결정립 크기 감소 현

상에서 미루어 볼때 0.5wt% 까지의 밀도 증가 현상은 Atkin 등의 Nb, Al을 첨가한 경우⁸⁾에서와 같이 식(1)의 결합 반응식에서 볼 수 있듯이 Mn 첨가에 따라 생성된 산소 공위(oxygen vacancy)에 기인되어 치밀화가 촉진된 결과로 생각한다. 한편 Fig.4의 미세구조 사진에서 MnO_2 첨가량이 많아지면 입계면에서 액상을 볼 수가 있으며 이 액상이 닿는 입자는 등그렇게 자란 것을 볼 수가 있다.

Fig.5는 etching 시편의 금속 현미경 사진으로서 0.75wt% MnO_2 이상부터는 이차상이 존재하고 있음을 보여주

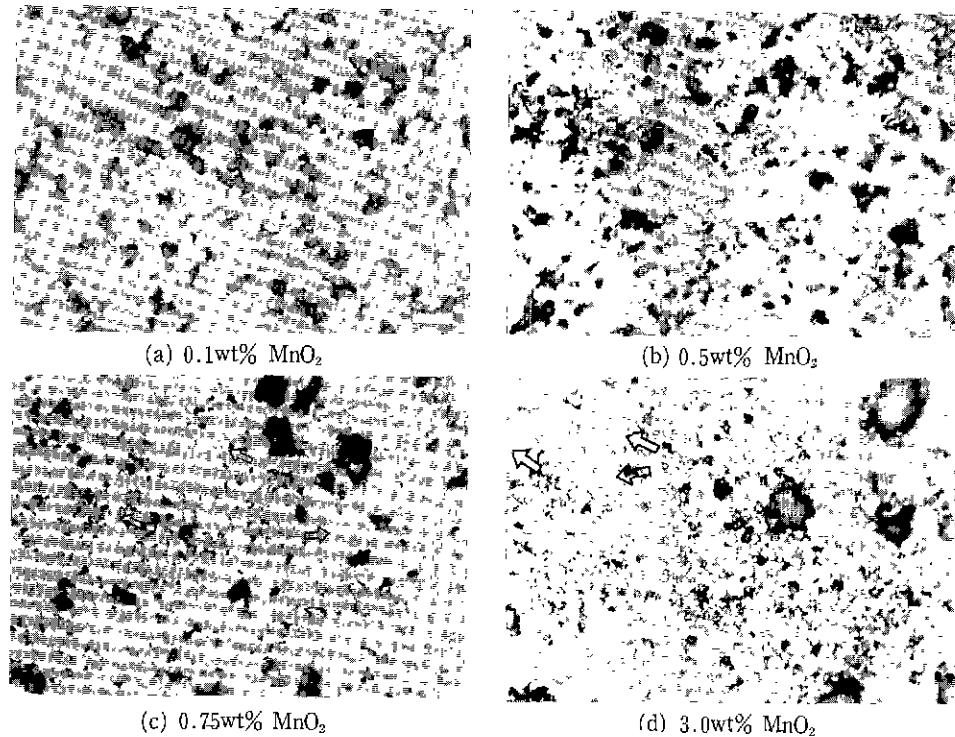


Fig.5. Optical micrographs of the Pb(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃ with MnO₂ addition. (bar : 10μm)

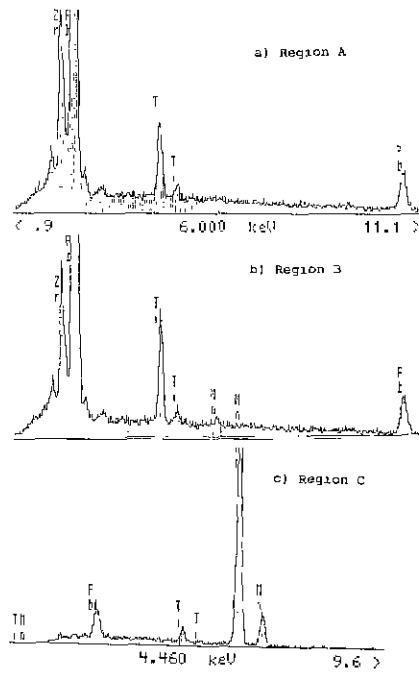
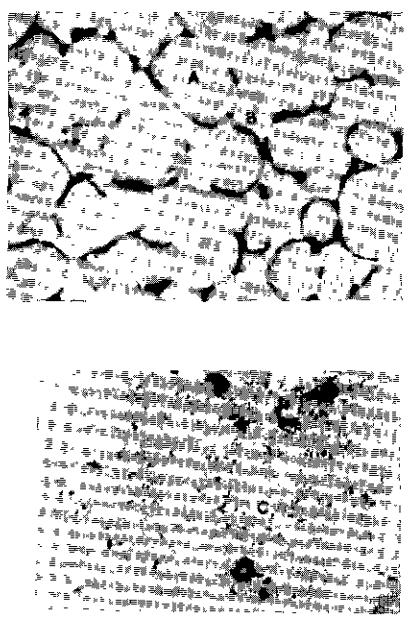


Fig.6. EDAX analysis of the 5.0wt% MnO₂ doped PZT ceramics.

고 있으며 첨가량 증가에 따라 이들 phase의 양은 점차적으로 증가하고 있다. 이는 고용한계 밖에서의 Mn의 불균질한 분포에 따른 현상⁹⁾으로 생각한다. 한편 Mn의 고용한계는 약 2.5mol% (0.677wt%) 정도로서 보고¹⁰⁾되고 있다.

Fig. 6은 5.0wt% MnO₂를 첨가한 경우 결정립과 결정입체 그리고 이차상에 대한 EDAX 분석 결과이다. 결정립 내에서는 EDAX 정화도 내에서는 Mn의 존재를 감지할 수 없었으나 Zr/Ti 비는 52/48과 균사적인 조성을 보여주고 있으며 결정입체에서는 Mn의 존재 및 Ti-rich 상태의 PZT (Zr/Ti=37/63의 조성비를 나타냄)의 존재를 보여주고 있다. 한편 이차상은 Mn이 주된 상을 이루며 Pb와 Ti가 미량 존재하고 있음을 EDAX 결과에서 알 수가 있다. 그러므로 고용한계 밖에서는 시판내에서 Mn의 존재상태는 불균질하게 분포되어 있음을 Fig. 5와 Fig. 6에서 볼 수가 있다. 또한 Fig. 5에서 볼 수 있듯이 Mn의 불균질한 분포를 나타내는 현상과 MnO₂가 주된 상을 이루는 부분들이 0.75wt% MnO₂ 이상부터 그 존재량이 증가하고 있으므로 Fig. 3에서 0.5wt% MnO₂ 이상에서 완만한 수축을 증가현상에 대한 밀도의 감소현상은 PZT 보다 비중이 작은 MnO₂ (비중=5.026)의 존재량이 늘어남에 따른 효과일 것으로 생각한다.

Fig. 7은 MnO₂의 첨가량에 따른 상온 저항률 변화를 나타낸 것으로서 0.5wt% MnO₂까지 약간의 저항 감소현상을 보여주고 그 이상부터는 급격한 저항 감소현상을 보여주고 있다. PZT는 Pb site vacancy에 기인되어 p-type 특성을 보여 주는데¹¹⁾ 식(1)의 결합 반응식에서 볼 수 있듯이 Mn³⁺로 (Zr, Ti) 격자 site에 치환되어 들어감에 따라 산소 공위의 농도는 증가하나 전도가 hole에 의

하여 일어나며 Mn³⁺가 acceptor로 작용함에 따라 저항률이 감소¹¹⁾한다고 볼 수 있다. 그러나 0.5wt% 이상부터의 급속한 저항 감소 현상은 Takahashi가 보고¹²⁾한 바와 같이 결정입체에 저항률이 작은 불순물 Layer가 형성됨에 따른 효과로서 생각한다.

Fig. 8은 유전상수 및 tanδ 변화를 나타낸 것이다. 0.5wt% MnO₂ 까지 유전상수 및 tanδ는 완만한 감소를 보여주다가 그 이상부터는 급속하게 증가하고 있다. Fig. 9와 Fig. 10은 주파수에 따른 capacitance 및 tanδ의 변화를 나타낸 것이다.

0.5wt% MnO₂ 까지의 유전상수 및 tanδ가 밀도 증가와 결정립 크기의 감소에도 불구하고 감소하는 현상은 MnO₂ 첨가량 증가에 따라 전하 보상을 위하여 생성된 산

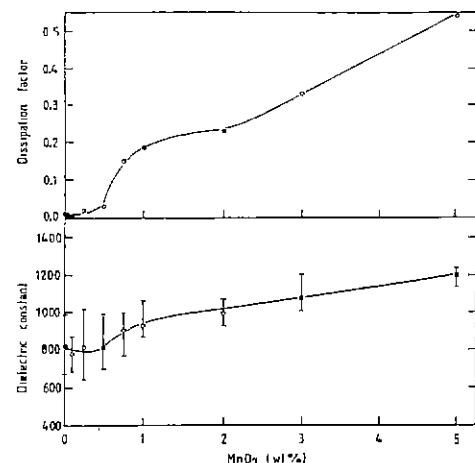


Fig. 8. Variation of dielectric constant and tanδ with MnO₂ addition.

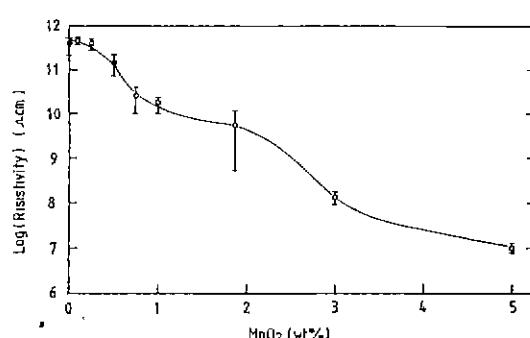


Fig. 7. Variation of resistivity at room temperature with MnO₂ addition.

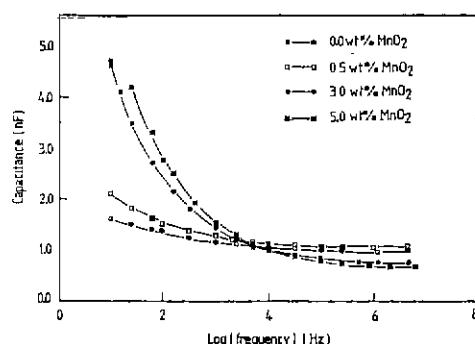


Fig. 9. Frequency dependence of capacitance for the MnO₂ doped PZT ceramic.

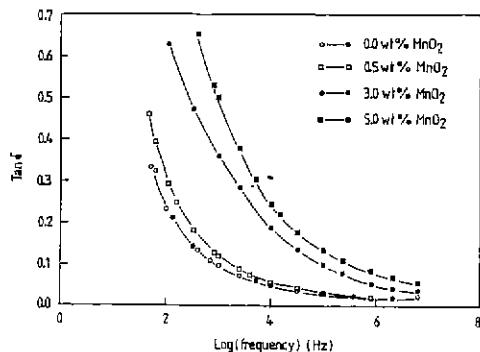


Fig. 10. Frequency dependence of $\tan\delta$ for the MnO_2 -doped PZT ceramics.

소 공위가 $\text{Mn}-\text{V}_o$ associate를 형성⁸⁾하여 이들이 domain 안정화 역할 즉, domain 이동을 억제하는 역할을 하므로 polarizability가 감소하게 되어 유전 상수가 감소하게 되는 것으로 본다. 그러나, 첨가량에 따른 유전 상수 및 $\tan\delta$ 의 감소가 적은 이유는 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 기공율 차이에 따른 영향으로 생각한다^{1,2)}.

한편 0.5wt% MnO_2 이상에서는 미세구조상의 커다란 변화가 없음에도 급속한 유전 상수 및 $\tan\delta$ 의 증가 현상을 보여주는 것은 Fig. 7에서 설명한 바와 같이 낮은 저항을 갖는 impurity layer가 형성되어 Takahashi의 보고¹²⁾와 같이 지향 감소를 초래하여 $\tan\delta$ 의 급속한 증가현상을 나타내며 또 이들 impurity layer가 interfacial polarization을 증가시켜서 유전 상수의 급속한 증가를 보여준다고 생각된다. 이는 Fig. 9 및 Fig. 10의 capacitance 및 $\tan\delta$ 의 주파수 의존성에서 0.5wt%까지는 주파수에 따른 유전 상수 및 $\tan\delta$ 의 변화가 거의 없으나 과잉의 MnO_2 가 첨가되었을 때는 주파수 증가에 따른 유전 상수 및 $\tan\delta$ 의 변화율이 큰 현상에서 예상할 수가 있으며 낮은 주파수 범위에서 유전 상수는 시편의 결정 결합 혹은 불순물에 의한 interfacial polarization에 크게 의존하게 된다. Kahn¹³⁾도 Nb-doped BaTiO₃에서 높은 유전 상수와 $\tan\delta$ 값이 나타나며 또한 이 경우 주파수 의존성이 매우 크다고 보고하였으며 Coelho¹⁴⁾는 second phase의 존재를 통하여 interfacial polarization이 발생한다고 하였으며 유전체 내부에서 서로 다른 유전율과 전도도를 갖는 부분들의 값의 차이에 기인되어 field를 걸었을 때 Charge들은 서로 다른 부분들 사이의 boundary에 축적되므로서 발생하게 된다고 보고하고 있다¹⁴⁾. 그러므로

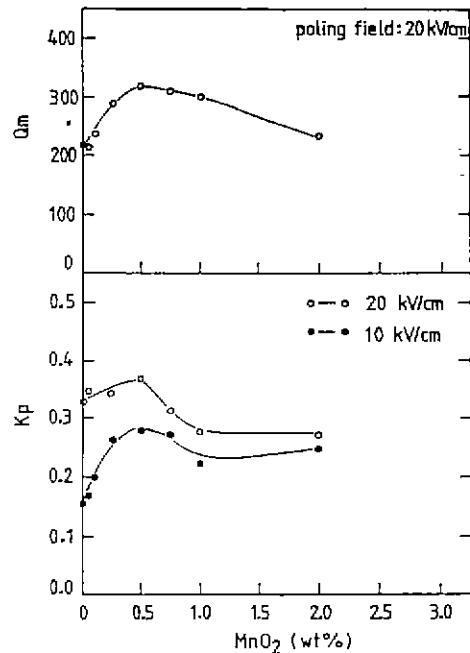


Fig. 11. Variation of K_p and Q_m with MnO_2 addition.

Fig. 9와 Fig. 10에서 과잉의 MnO_2 가 첨가된 경우 유전 상수와 $\tan\delta$ 의 주파수 의존성이 매우 큰 것으로 보아 저 저항의 impurity layer(second phase)의 존재에 따른 interfacial polarization 효과^{13,14)}에 의해 0.5wt% MnO_2 이상에서 유전 상수 및 $\tan\delta$ 가 급격히 증가하게 되는 것으로 생각한다.

Fig. 11은 첨가량에 따른 K_p 와 Q_m 변화를 나타낸 것이며 0.5wt% MnO_2 까지 증가하다가 감소하는 경향을 보여주고 있다. K_p 는 분극조건, 결정립 크기, 밀도 등에 의존하는데^{1,15)} 결정립 크기의 감소에도 불구하고 K_p 가 증가하는 이유는 Fig. 3에서 보는 바와 같이 밀도 증가 및 기공율 감소에 기인되는 것으로 생각한다 한편 Q_m 은 첨가량 증가에 따라 Fig. 8에서 논의한 바와 같이 $\text{Mn}-\text{V}_o$ associates에 의하여 domain wall의 이동이 억제됨⁸⁾에 따라 0.5wt% MnO_2 까지 증가하다 감소하는 것으로 생각한다.

4. 결 론

- 1) MnO_2 는 Mn^{3+} 의 형태로 PZT 내의 (Zr, Ti) 위치로 치환되는 것으로 고려되며 Pb_{(Zr_{0.52} Ti_{0.48})O₃}에 대한 MnO_2 의 고용한계는 약 0.5wt% MnO_2 로서 첨가량 증가에

따라 밀도증가 및 결정립 크기와 tetragonality 감소효과를 보여 주었다. 또한 유전상수는 약간 감소하였으나 K_p 와 Q_m 은 증가하였다.

2) 0.75wt% 이상의 MnO_2 첨가의 경우 MnO_2 의 분포는 불균질하였으며 급속한 저항감소와 유전상수의 증가 및 $\tan\delta$ 의 증가현상을 나타내었다.

REFERENCE

1. 岡崎 清, "Ceramic 誘電體 工學" 學獻社 (1983).
2. 田中哲郎, 岡崎清, 一昇, "壓電 Ceramic 材料" 學獻社 (1973).
3. Hiromu Ouchi, Masamitsu Nishida and Shigeru Hayakawa, "Piezoelectric Properties of $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $PbTiO_3$ - $PbZrO_3$ Ceramics Modified with Certain Additives", *J. Am. Ceram. Soc.*, **49** (11) 577-582 (1966).
4. W.L. Zhong, "Stabilization Effects of Manganese and Cerium on the Properties of PZT Ceramics", *Ferroelectrics Letters*, **2**, 13-16 (1984).
5. H.J. Hagemann, "Loss Mechanism and Domain Stabilization in Doped $BaTiO_3$ ", *J. Phys. C. Solid State Phys.*, **11** (15) 3333-3344 (1978).
6. W.R. Cook Jr., Discussion of "Evaluation of Lattice Site and Valence of Mn and Fe in Polycrystalline $PbTiO_3$ by Electron Spin Resonance and Thermogravimetry", *J. Am. Ceram. Soc.*, **58**, 151 (1975).
7. K. H. Hardtl, "Defect Structure of PLZT Doped with Mn, Fe, and Al", *J. Am. Ceram. Soc.*, **64** (5) 283-288 (1981).
8. R. B. Atkin and R M. Fulrath, "Point Defects and Sintering of Lead Zirconate-Titanate", *J. Am. Ceram. Soc.*, **54** (5) 265-270 (1971).
9. P.V. Lambeck and G.H. Jonker, "The Nature of Domain Stabilization in Ferroelectric Perovskites", *J. Phys. Chem. Solids*, **47** (5) 453-461 (1971).
10. H. Thomann and W. Wersing, "Principles of Piezoelectric Ceramics for Mechanical Filters", *Ferroelectrics*, **40**, 189-202 (1982).
11. J.J. Dih and R M. Fulrath, "Electrical Conductivity in Lead Zirconate-Titanate Ceramics", *J. Am. Ceram. Soc.*, **61** (9-10) 448-451 (1978).
12. Masao Takahashi, "Electrical Resistivity of Lead Zirconate-Titanate Ceramics Containing Impurities", *Jpn. J. Appl. Phys.*, **10** (5) 453-451 (1971).
13. M. Kahn, "Influence of Grain Growth on Dielectric Properties of Nb-doped $BaTiO_3$ ", *J. Am. Ceram. Soc.*, **54** (9) 455-457 (1971).
14. Roland Coelho, "Physics of Dielectrics for the Engineer", Elsevier Scientific Publishing Co., p. 88-93, (1979).
15. S.S. Chiang, R.M. Fulrath and J. A. Pask, "Influence of Microcracking and Slow Crack Growth on the Planar Coupling Coefficient in PZT", *J. Am. Ceram. Soc.*, **64**, c-141 (1981).